

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 前澤宏一 副委員長 津田邦男

幹事 松永高治・鈴木寿一 幹事補佐 新井 学・東脇正高

日時 1月20日(水) 10:30~16:20

会場 機械振興会館地下3階1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 パワーデバイス及び超高周波デバイス/マイクロ波一般

1. [依頼講演] SiC基板の評価技術とデバイス特性 北畠 真 (FUPET)
2. [依頼講演] 3.3kV耐圧SiC-MOSFETの低抵抗化技術と世界初鉄道車両用フルSiC適用インバータの実現
○濱田憲治・日野史郎・三浦成久・渡邊 寛・中田修平・末川英介・海老池勇史・今泉昌之・梅壽 勲・山川 聡 (三菱電機)
3. [依頼講演] 酸化ガリウムパワーデバイスの最新技術
○東脇正高・ワン マンホイ・小西敬太 (NICT)・佐々木公平 (タムラ/NICT)・後藤 健 (タムラ/東京農工大)・野村一城・ティユ クァン トゥ・富樫理恵・村上 尚・熊谷義直・Bo Monemar・瀨瀬明伯 (東京農工大)・倉又朗人・増井建和・山腰茂伸 (タムラ)
4. [依頼講演] GaNパワーデバイスの特長とそれを活かす技術
○中原 健・近松健太郎・山口敦司・黒田尚孝 (ローム)
5. [依頼講演] 等価回路モデルを利用したレクテナRF-DC変換効率計算—大電力RFデバイスに適した半導体材料の検討— ○大石敏之・嘉数 誠 (佐賀大)
6. [依頼講演] GaNショットキーバリアダイオードとマイクロ波無線電力伝送 大野泰夫 (レーザーシステム)
7. [依頼講演] テラヘルツIC用InP HEMTの高 f_{max} 化
○高橋 剛・川野陽一・牧山剛三・芝 祥一・中舎安宏・原 直紀 (富士通研)
8. GaN HEMTユニットセルにおけるミリ波発振の解析
○渡辺伸介・今井翔平・桑田英悟・小山英寿・加茂宣卓・山本佳嗣 (三菱電機)
9. [依頼講演] 高周波用GaN-HEMTの開発 川合貴久 (SEDI)

☆ED研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月3日(木), 4日(金) 北大百年記念会館〔未定〕テーマ:機能ナノデバイス及び関連技術

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

松永高治 (NEC)

TEL [044] 435-8348, FAX [044] 455-8253

E-mail: k-matsunaga@fp.jp.nec.com

鈴木寿一 (北陸先端大)

TEL [0761] 51-1441, FAX [0761] 51-1455

E-mail: tosikazu@jaist.ac.jp